1S1585~ 1S1588

シリコンエピタキシアルプレーナ形ダイオード

参考資料

単位: mm

○ 通信,制御,計測機器用

○ 超高速度スイッチング用

外形が小さい。 : DO-7の約1/4の体積
許容電力損失が大きい。: P=300mW(最大)

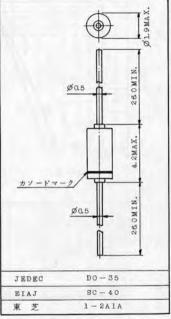
順方向特性が良い。 : V_F= 1.0V(最大)

 $(I_F = 100mA)(1S1585)$

逆回復時間が小さい。 : t_{rr}=2ns (最大)
端子間容量が小さい。 : C_T=2pF (最大)

最大定格 (Ta=25℃)

項	目	記号	定 格	単位	
	181585	V _{RM}	90		
	181586				
せん頭逆電圧	181587		55	٧	
	181588		35		
	181585	ν _R	80		
逆電圧	181586			v	
逆電圧	181587		50	v	
	181588		30		
	181585	IFM			
4 / 西斯伊 *	181586		480		
せん頭順電流	181587		400	mA	
	181588		360		
	181585	10	150		
平均整流電流	181586				
	181587		130	m A	
	181588		120		
サージ電流(1sec)	181585		700		
	181586	Isurge	700		
	181587		600	m A	
	181588	7 2	500		
許 容 抽	英 失	P	300	mW	
接 合 证	展 度	Тј	175	°C	
保 存 1	且 度	Tstg	-65~175	°C	



注:現品には次の通り形名表示され ております。

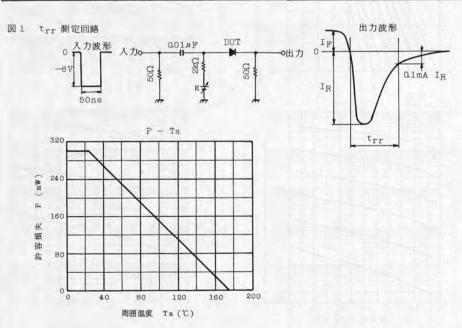
181585	T5 (青色マーク)	
181586	IL T6 (青色マーク)	
181587	177 (青色マーク)	
181588	丁 (青色マーク)	

1S1585~ 1S1588

電気的特性(Ta=25℃)

1	項		B	記号	測 定 条 件	最 小	標準	最 大	单位
順電	Œ	181585	v _F			-	1.0	٧	
		181586		1 _F =100mA					
	-	A.A.	181587	, P	1 p = 100 m A	-	1	1.2	
		181588			-	1	1.3		
逆電		181585		V _R =80V					
	雷	流	181586	I_{R}	V _R = 50V	-	-	0.5	μΑ
	-	OIL.	181587		VR-50V				
		181588		V _R = 30V					
端 子 間 容		181585			AMILE.	1 = 9			
	子間 宏	-	181586	CT	$V_{\mathrm{R}} = 0$, $f = 1 \mathrm{MHz}$	-	-	2	pF
	, 144 12		181587	OT					
	1815	181588			-	-	3		
逆回復時		181585							
	可加時	[10]	181586	trr	$V_R = 6V$, $I_F = 10 \text{ mA}$ $R_L = 100 \Omega$ ($\boxtimes 1$)	-	-	2	ns
	- EX "U	1-3	181587						
	18	181588			-	-	4		

1



1S1585~ 1S1588

